

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成24年2月16日 (2012.2.16)

【公開番号】特開2010-242187(P2010-242187A)

【公開日】平成22年10月28日 (2010.10.28)

【年通号数】公開・登録公報2010-043

【出願番号】特願2009-93549(P2009-93549)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/40 (2006.01)

H 0 1 L 21/285 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 21/314 (2006.01)

【 F I 】

C 2 3 C 16/40

H 0 1 L 21/285 C

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 21/88 M

H 0 1 L 21/314 A

【手続補正書】

【提出日】平成23年12月1日 (2011.12.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】

前記酸化マンガン膜が、 MnO の層、 MnO と SiO_x との混合層、 $Mn(OH)_2$ と MnO との混合層、及び $Mn(OH)_2$ の層の少なくともいずれか一つを含むことを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか一項に記載の酸化マンガン膜の形成方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 10】

前記酸化マンガン膜の成膜法が、熱 CVD 法であることを特徴とする請求項 7 から請求項 9 のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。